

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 11.04.04 Электроника и нанoeлектроника

Наименование образовательной программы: Твердотельная микро- и нанoeлектроника

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная


**Оценочные материалы
по дисциплине
Современные методы исследования поверхности полупроводников**

**Москва
2022**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Баринов А.Д.
	Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f

(подпись)


А.Д. Баринов

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень,
ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Баринов А.Д.
	Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f


(подпись)

А.Д. Баринов

(расшифровка подписи)

Заведующий
выпускающей
кафедры

(должность, ученая степень,
ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Мирошникова И.Н.
	Идентификатор	Rd1db27a5-MiroshnikovaIN-70cafb8

(подпись)

И.Н.

Мирошникова

(расшифровка подписи)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ОПК-1 способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора

ИД-1 Знает тенденции и перспективы развития электроники и нанoeлектроники, а также смежных областей науки и техники

2. ПК-1 Способен участвовать в проектировании полупроводниковых приборов и / или интегральных схем

ИД-2 Демонстрирует знание методов контроля производства и исследования полупроводниковых структур

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации:

1. Расчётное задание по теме "Рентгеноспектральный микроанализ" (Расчётно-графическая работа)

Форма реализации: Билеты (письменный опрос)

1. Контрольная работа по теме: «Ионная спектроскопия» (Контрольная работа)
2. Контрольная работа по теме: «Электронная спектроскопия» (Контрольная работа)
3. Опрос по теме "Перспективные методы исследования" (Проверочная работа)
4. Опрос по теме "Проблемы физики поверхности" (Проверочная работа)

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Расчётное задание по теме "Резерфордовское обратное рассеяние" (Расчётно-графическая работа)

БРС дисциплины

3 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %						
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5	КМ-6
	Срок КМ:	2	6	8	12	15	15
Фундаментальные и прикладные проблемы физики поверхности твёрдого тела							
Поверхность	+						
Вакуум	+						

Классификация аналитических методов исследования поверхности	+					
Ионная спектроскопия						
Методы ионной спектроскопии		+	+			
Масс-спектроскопия вторичных ионов		+	+			
Электронная и рентгеновская спектроскопии						
Методы электронной спектроскопии				+	+	
Методы рентгеновской спектроскопии				+	+	
Перспективные методы анализа. Сравнительный анализ методов						
Перспективные методы анализа						+
Вес КМ:	5	25	20	25	20	5

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ОПК-1	ИД-1 _{ОПК-1} Знает тенденции и перспективы развития электроники и нанoeлектроники, а также смежных областей науки и техники	Знать: перспективные методы исследования	Опрос по теме "Перспективные методы исследования" (Проверочная работа)
ПК-1	ИД-2 _{ПК-1} Демонстрирует знание методов контроля производства и исследования полупроводниковых структур	Знать: физические основы и аппаратную реализацию электронных и рентгеновских методов исследования поверхности полупроводников и тонких плёнок проблемы физики поверхности физические основы и аппаратную реализацию ионных методов исследования поверхности полупроводников и тонких плёнок Уметь: проводить анализ и расчёт параметров для	Опрос по теме "Проблемы физики поверхности" (Проверочная работа) Контрольная работа по теме: «Ионная спектроскопия» (Контрольная работа) Расчётное задание по теме "Резерфордовское обратное рассеяние" (Расчетно-графическая работа) Контрольная работа по теме: «Электронная спектроскопия» (Контрольная работа) Расчётное задание по теме "Рентгеноспектральный микроанализ" (Расчетно-графическая работа)

		электронной и рентгеновской спектроскопий проводить анализ и расчёт параметров для ионной спектроскопии	
--	--	---	--

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Опрос по теме "Проблемы физики поверхности"

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 5

Процедура проведения контрольного мероприятия: В билете несколько вопросов, на которые студенту требуется ответить. Время проведения работы - 45 минут

Краткое содержание задания:

Ответьте на вопросы

Контрольные вопросы/задания:

Знать: проблемы физики поверхности	1.Какие проблемы физики поверхности Вы можете привести в качестве примера в области оптоэлектроники? 2.Какие проблемы физики поверхности Вы можете привести в качестве примера в области газовой сенсорики? 3.Почему исследование поверхности в основном проводят в сверхвысоком вакууме?
------------------------------------	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-2. Контрольная работа по теме: «Ионная спектроскопия»

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: В билете 4 вопроса: три теоретических и один практический. Теоретическую часть студент пишет на бумаге, а практическую решает с использованием компьютера

Краткое содержание задания:

Ответьте на вопросы билета

Контрольные вопросы/задания:

<p>Знать: физические основы и аппаратную реализацию ионных методов исследования поверхности полупроводников и тонких плёнок</p>	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Дифференциальным сечением рассеяния</i> называют Чем оно отличается от <i>полного сечения рассеяния</i>?2. Почему чувствительность к тяжёлым элементам в спектроскопии ионного рассеяния выше, чем к лёгким?3. Поясните принцип работы квадрупольного масс-анализатора.4. Что называют явлением <i>затенения</i> и «<i>конусом тени</i>» в спектроскопии ионного рассеяния?5. Чем обусловлена поверхностная чувствительность в спектроскопии рассеяния медленных ионов (СРМИ)?6. Поясните принцип работы время-пролётного масс-анализатора.7. Поясните принцип работы электростатического анализатора.8. Почему количественный анализ в методе вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС) затруднителен?9. <i>Прицельным параметром</i> называют Угол рассеяния будет выше у частицы, летящей с большим или меньшим прицельным параметром? Поясните ответ.10. Поясните принцип работы магнитного масс-анализатора.11. С чем связано наличие ограничения применения формулы Резерфорда для сечения рассеяния при низких и высоких энергиях?12. Что называют «<i>каналированием</i>»?
<p>Уметь: проводить анализ и расчёт параметров для ионной спектроскопии</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Оцените минимальное поверхностное содержание бора (атом/см²) в монокристаллическом кремнии, определяемое методом резерфордовского обратного рассеяния (РОР), которое может быть обнаружено с помощью детектора площадью 1 см², расположенного под углом рассеяния 170° на расстоянии 5 см от мишени. Считать, что порог регистрации составляет 100 событий в час (ионов в час); величина тока ионов ⁴He⁺ с энергией 1,5 МэВ равна 10 мкА (плотность тока 10 мА/см²). Сравните полученный результат с плотностью атомов монослоя (порядка 10¹⁵ атом/см²) – во сколько раз больше или меньше. <i>Обратите внимание: длительность проведения эксперимента неизвестна. Для удобства рекомендуется изобразить схему эксперимента.</i>2. На ситалловую подложку нанесли плёнку аморфного кремния <i>a</i>-Si толщиной 0,5 мкм. Поверхность плёнки бомбардируют ионами ¹⁶O⁺ и ⁴⁰Ar⁺ с энергией 50 кэВ. Достигнут ли ионы подложки? Плотность аморфного кремния принять равной 2,33 г/см³. <i>Для удобства рекомендуется</i>

	<p><i>изобразить схему эксперимента.</i></p> <p>3. Оцените скорость потерь энергии [$\text{эВ}/\text{\AA}$] и сечение торможения ϵ [$\text{эВ}\cdot\text{см}^2/(1015 \text{ ат})$] для ионов 4He^+ с энергией 1 МэВ в соединении SiGe, нанесённом на кремниевую подложку. Какую энергию будут иметь обратно рассеянные от атомов поверхности подложки ионы при толщине плёнки 0,1 мкм (угол рассеяния 170°)? Плотность мишени принять равной 3,83 г/см³. <i>Для удобства рекомендуется изобразить схему эксперимента.</i></p> <p>4. Поверхность антимонида индия InAs бомбардируют ионами аргона 40Ar^+ с энергией 3 кэВ при плотности тока 7 мкА/см². Время травления составляет 5 минут. Определите толщину протравленного слоя. Энергию связи атомов с поверхностью принять равной 3 эВ. Плотность InAs принять равной 5,8 г/см³, молярную массу – 236,6 г/моль. Поправочный множитель α принять равным 0,25. <i>При расчёте коэффициента S_n рекомендуется использовать усреднённые массы и заряды для параметров мишени. Для удобства рекомендуется изобразить схему эксперимента.</i></p>
--	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-3. Расчётное задание по теме "Резерфордовское обратное рассеяние"

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Расчетно-графическая работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Задание выполняется на компьютере

Краткое содержание задания:

Ионы гелия 4He^+ с энергией 2 МэВ бомбардируют поверхность плёнки толщиной t , мкм, покрытой с обеих сторон монослоем металла (наличием подложки пренебречь).

Выполнить:

1. Постройте кривые зависимости сечения торможения от энергии иона для каждого из элементов плёнки, а также для материала самой плёнки на одном графике в диапазоне энергий от 0,5 до 3 МэВ.
2. Постройте спектр обратного рассеяния, укажите особенности спектра (начало, конец, высоту и ширину).

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: проводить анализ и расчёт параметров для ионной спектроскопии	1.Постройте спектр обратного рассеяния
--	--

Описание шкалы оценивания:*Оценка: 5**Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно*Оценка: 4**Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач*Оценка: 3**Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено**КМ-4. Контрольная работа по теме: «Электронная спектроскопия»****Формы реализации:** Билеты (письменный опрос)**Тип контрольного мероприятия:** Контрольная работа**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25**Процедура проведения контрольного мероприятия:** В билете 4 вопроса: три теоретических и один практический. Теоретическую часть студент пишет на бумаге, а практическую решает с использованием компьютера**Краткое содержание задания:**

Ответьте на вопросы билета

Контрольные вопросы/задания:

Знать: физические основы и аппаратную реализацию электронных и рентгеновских методов исследования поверхности полупроводников и тонких плёнок	1.Электронный пучок с энергией E_0 взаимодействует с поверхностью твёрдого тела. Как выглядит энергетический спектр электронов, образовавшихся в результате взаимодействия? Нарисуйте его и поясните. (10 баллов) 2.С чем связано повышенное разрешение электронного микроскопа по сравнению с оптическим микроскопом? (15 баллов) 3.Поясните, по какой причине Оже-электронная спектроскопия обладает поверхностной чувствительностью и чувствительностью к лёгким элементам? (25 баллов) 4.Поясните, с какой целью в Оже-электронной спектроскопии проводят дифференцирование спектра? (15 баллов) 5.Поясните, по какой причине рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия обладает поверхностной чувствительностью? (25 баллов) 6.Какие Оже-переходы называют <i>переходами Костера-Кронига</i> ? С чем связано увеличение ширины их спектральной линии по сравнению с обычными ССС Оже-переходами? Поясните, что
---	--

	<p>такое <i>ССС Оже-переход</i>? (15 баллов)</p> <p>7.Поясните, чем определяется форма Оже- и фотоэлектронного спектров при исследовании валентной зоны полупроводникового соединения? Какую информацию и почему можно получить, проводя это исследование? (25 баллов)</p> <p>8.Нарисуйте схематически и поясните принцип работы детектора вторичных электронов типа Эверхарта-Торнли. (15 баллов)</p> <p>9.С чем связано затруднение при количественном анализе лёгких элементов методом рентгеноспектрального микроанализа? (25 баллов)</p>
<p>Уметь: проводить анализ и расчёт параметров для электронной и рентгеновской спектроскопий</p>	<p>1.Элементный состав диэлектрической мишени SixNy исследуют методом рентгеноспектрального микроанализа. Для этого поверхность облучают электронным пучком с энергией 5 кэВ и интенсивностью I_0. Детектор располагается под углом 45° к поверхности мишени. Для минимизации эффекта зарядки на поверхность напылили слой Al толщиной 10 нм. Определите, во сколько раз изменилась после напыления интенсивность рентгеновской линии SiKα? (50 баллов)</p> <p>2.Методом рентгеноспектрального микроанализа исследуют элементный состав плёнки SixGe1-x, Определите параметр x и запишите химическую формулу материала плёнки, если отношение интенсивностей линий SiKα и GeKα составляет 1:44. Указание: долю регистрируемых квантов считать одинаковой для обоих элементов, пренебречь поглощением рентгеновского излучения в окне детектора. (50 баллов)</p> <p>3.Определите, возможны ли переходы KL1L3 для He, Li, C, O, Si, W при облучении их электронным пучком с энергией 2 кэВ? Поясните ответ. (50 баллов)</p> <p>4.Какова величина средней длины свободного пробега электрона с энергией 200 эВ и 2000 эВ в плёнке Au? Определите, при какой толщине плёнки интенсивность прошедших электронов уменьшится в 10 раз по отношению к падающим. Указание: считать, что энергию электрон теряет только на возбуждение плазмонов. (50 баллов)</p>

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 95

Описание характеристики выполнения знания:

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания:

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания:

КМ-5. Расчётное задание по теме "Рентгеноспектральный микроанализ"

Формы реализации:

Тип контрольного мероприятия: Расчетно-графическая работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Задание выполняется на компьютере

Краткое содержание задания:

Проводится рентгеноспектральный анализ мишени бинарного соединения $AnBm$.

1. Подобрать энергию пучка электронов исходя из величины перенапряжения для K-, L- или M-уровня тяжёлого элемента, но не более 20 кэВ.

2. Рассчитать массовый коэффициент поглощения.

3. Оценить глубину генерации рентгеновского излучения.

4. Рассчитать k -отношение и отношение интенсивностей рентгеновских линий каждого элемента.

5 (доп.). Для каждого элемента мишени построить графики зависимости массового коэффициента поглощения от энергии рентгеновского излучения в диапазоне от 1 до 30 кэВ.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: проводить анализ и расчёт параметров для электронной и рентгеновской спектроскопий	1. Определите параметры рентгеноспектрального микроанализа
---	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-6. Опрос по теме "Перспективные методы исследования"

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 5

Процедура проведения контрольного мероприятия: В билете несколько вопросов, на которые студенту требуется ответить. Время проведения работы - 45 минут

Краткое содержание задания:

Ответьте на вопросы

Контрольные вопросы/задания:

Знать: перспективные методы исследования	1. Какую информацию можно получить при исследовании атомно-силовой микроскопией?
--	--

	<p>2.Какую информацию можно получить при исследовании сканирующей туннельной микроскопией?</p> <p>3.Какую информацию можно получить при исследовании спектроскопией характеристических потерь энергии электронами?</p>
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Пример билета

В плёнку аморфного углерода a -C вводится молибден Mo. Известно, что этот переходный металл образует два карбида: **MoC** и **Mo₂C**. У Вас есть возможность исследования плёнки методами резерфордовского обратного рассеяния (РОР), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Каким из этих методов исследования Вы можете установить наличие в плёнке вида карбида молибдена (определить химическое состояние молибдена) и почему?

Процедура проведения

Задание выполняется не более 20 мин. После подготовки происходит беседа с оцениванием аргументации решения задания.

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1_{ОПК-1} Знает тенденции и перспективы развития электроники и нанoeлектроники, а также смежных областей науки и техники

Вопросы, задания

1. В плёнку аморфного углерода a -C вводится молибден Mo. Известно, что этот переходный металл образует два карбида: **MoC** и **Mo₂C**. У Вас есть возможность исследования плёнки методами резерфордовского обратного рассеяния (РОР), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Каким из этих методов исследования Вы можете установить наличие в плёнке вида карбида молибдена (определить химическое состояние молибдена) и почему?

2. На поверхности серебра при температуре 300 К на воздухе происходит адсорбция атомов кислорода. Перед Вами стоит задача определения механизма роста слоя адсорбата (как атомы кислорода взаимодействуют с атомами серебра на поверхности, какие химические связи образуют и пр.). Каким из предложенных методов исследования Вы воспользуетесь: ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия (УФЭС), резерфордовское обратное рассеяние (РОР) или рентгеноспектральный микроанализ (РСМА)? Почему?

3. Плёнка аморфного углерода a -C гидрогенизируется (a -C:H). У Вас есть возможность исследования плёнки методами вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Каким из этих методов исследования Вы можете установить наличие и концентрацию атомов водорода в плёнке и почему?

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Метод резерфордовского обратного рассеяния может дать информацию о ...

Ответы:

элементном составе
химическом составе

Верный ответ: элементном составе

2. Информацию о химическом составе на основе химического сдвига может дать ...

Ответы:

спектроскопия Резерфордского обратного рассеяния

дифракция быстрых электронов

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

Верный ответ: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

3. Информацию о структуре материала (аморфный, поликристаллический или монокристаллический) может дать ...

Ответы:

же-электронная спектроскопия

дифракция электронов

вторичная ионная масс-спектрометрия

Верный ответ: дифракция электронов

4. Фотоэлектроном называют вылетевший с энергетического уровня в результате ...

Ответы:

ударной ионизации

взаимодействия с электромагнитным излучением

Верный ответ: взаимодействия с электромагнитным излучением

2. Компетенция/Индикатор: ИД-2ПК-1 Демонстрирует знание методов контроля производства и исследования полупроводниковых структур

Вопросы, задания

1. Перед Вами стоит задача определения кристаллической структуры материала: монокристалл, поликристалл или аморфный. Есть возможность использовать спектроскопию рассеяния медленных ионов (СРМИ), дифракцию медленных электронов (ДМЭ) или рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию (РФЭС). Каким методом Вы воспользуетесь и почему?

2. В плёнку аморфного углерода a -C вводится хром Cr. Известно, что этот металл образует несколько карбидов: Cr_3C_2 , Cr_7C_3 и $Cr_{23}C_6$. У Вас есть возможность исследования плёнки методами Резерфордского обратного рассеяния (РОР), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Каким из этих методов исследования Вы можете установить наличие в плёнке того или иного вида карбида хрома (определить химические связи) и почему?

3. При создании фотоприёмников на основе селенида свинца $PbSe$ фоточувствительный слой отжигается в атмосфере йода и кислорода $I_2 + O_2$. Перед Вами стоит задача определения вхождения йода в структуру материала (образование химических связей). Вы можете использовать рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию (РФЭС), дифракцию быстрых электронов (ДБЭ) или вторичную ионную масс-спектрометрию (ВИМС). Каким методом и почему Вы воспользуетесь?

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Информацию о содержании кислорода в материале может дать ...

Ответы:

вторичная ионная масс-спектрометрия

же-электронная спектроскопия

атомно-силовая микроскопия

Верный ответ: вторичная ионная масс-спектрометрия

2. Информацию о расположении атомов на поверхности материала может дать ...

Ответы:

атомно-силовая микроскопия

рентгеновская фото-электронная спектроскопия
спектроскопия рентгеновского поглощения

Верный ответ: атомно-силовая микроскопия

3. Коллективные колебания электронного газа называют квазичастицами ...

Ответы:

плазмоны

фотоны

фононы

Верный ответ: плазмоны

4. Поверхностной чувствительностью обладает ...

Ответы:

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

рентгеноспектральный микроанализ

спектроскопия рентгеновского поглощения

Верный ответ: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

5. Большой разрешающей способностью обладает метод картирования элементного состава в просвечивающем электронном микроскопе метод ...

Ответы:

рентгеноспектрального микроанализа

спектроскопии характеристических потерь энергии электронами

Верный ответ: спектроскопии характеристических потерь энергии электронами

6. Исследование поверхности различными методами проводится в условиях ...

Ответы:

сверхвысокого вакуума

низкого вакуума

атмосферы

Верный ответ: сверхвысокого вакуума

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу